

シリコンPNP三重拡散形トランジスタ

○ 電力增幅用

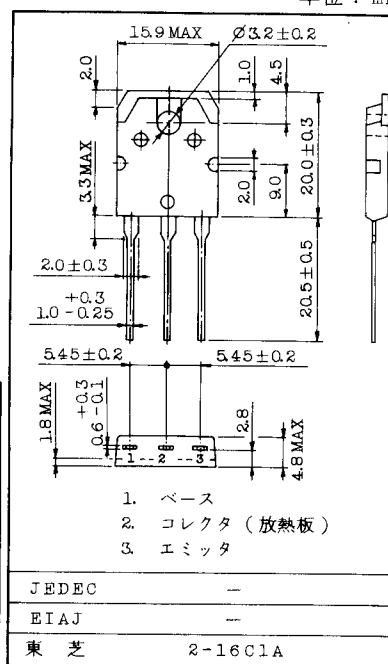
單位：mm

特 長

- ・ 高耐圧です。 : $V_{CEO} = -180V$ (最小)
- ・ 2SC3907 とコンプリメンタリになります。
- ・ 80W ハイファイ オーディオアンプ出力段に最適です。

最大定格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)

項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-180	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-180	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{EB0}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-12	A
ベース電流	I_B	-12	A
コレクタ損失 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	P_C	130	W
接合温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

電氣的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-180V, I_E=0$	—	—	-5.0	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5V, I_C=0$	—	—	-5.0	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-50mA, I_B=0$	-180	—	—	V
直 流 電 流 増 幅 率	$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE}=-5V, I_C=-1A$	55	—	180	—
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-5V, I_C=-7A$	35	80	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-8A, I_B=-0.8A$	—	-1.5	-3.0	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=-5V, I_C=-7A$	—	-1.0	-1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=-5V, I_C=-1A$	—	25	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$	—	470	—	pF

注： $h_{FE(1)}$ 分類 R：55～110，O：90～180